10uF/6.3V电容热冲击验证报告

一、客户乐鑫反馈ESP32-SIG1711P8试产模块可靠性试验中发现C10位电容有击穿现象。

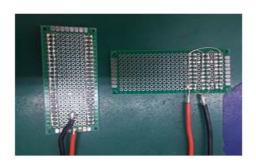




- 二、参考乐鑫可性试验
- 1、在温度85℃、湿度85%环境存贮196H
- 2、在温度85℃,湿度85%模拟工作196H
- E、相同试验条件,试验有三种规格物料分别是
 - A、10UF/6.3V电容,村田(Murata) GRM155C80J106ME11D (新物料)
 - B、1UF/10V电容,村田(Murata)GRM033C81A105ME05D(新物料)C、0.1UF/6.3V电容,三星(Samsung)CL05B104K05NNNC

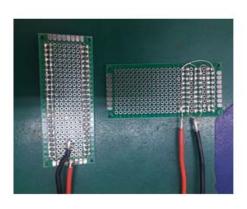
四、模拟试验

4.1、将产品模拟在温度85℃、湿度85%环境存贮





4.2、将产品模拟在温度85℃、湿度85%环境工作







五、试验验证结果

5.1试验条件及试验时间

字: 温度	俭条件 □温度	实验分类	实验时间	实验前测试	实验后测试	实验结果	备注
85	85	模拟存贮	24	OK	ок	ок	
85	85	模拟运行	24	OK	实验过程中出现漏电	NG	实验20小时发现有漏电1MA
85	85	模拟存贮	24				
85	85	模拟运行	24				
85	85	模拟存贮	24				
85	85	模拟运行	24				
85	85	模拟存贮	24				
85	85	模拟运行	24				
85	85	模拟存贮	24				
85	85	模拟运行	24				
85	85	模拟存贮	24				
85	85	模拟运行	24				
85	85	模拟存贮	24				
85	85	模拟运行	24				

5.2、10uF/6.3V在温度85℃,湿度85模拟运行,出现漏电现象。(试验数量为50PCS,有1PCS出在漏电现象)

5.2、其它两种规格物料没出现漏电现象。